# آنالیز انرژی و اگزرژی سلولهای فتوولتائیک-حرارتی با مدلسازی توسط نرمافزار TRANSYS و بررسی عوامل موثر بر آنها

ایلقار اطهری'، فرشاد ترابی'، احمد توسلی<sup>۳</sup>

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشکده محیط زیست و انرژی +انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی به سمت حصارک elgar.athari@gmail.com

# چکیدہ

عملکرد سلولهای فتوولتائیک-حرارتی تحت تأثیر پارامترهای مختلفی از جمله دما است. همچنین برای ارزیابی عملکرد سلول فتوولتائیک-حرارتی،دانستن ضریب تلفات کلی که خود وابسته به شرایط آب و هوایی است ضروری است. در این تحقیق با مدلسازی یک سیستم فتوولتائیک-حرارتی با استفاده از نرم افزار TRANSYS رفتار دینامیکی دمای سیال خروجی از سلول فتوولتائیک-حرارتی، دمای سلول، بازده الکتریکی،بازده حرارتی تحلیل شده و عوامل موثر بر افزایش راندمان انرژی و اگزرژی بررسی شد.نتایج حاصل از تغییرات دبی سیال نشان داد که حالت بهینه دبی سیال وقتی راندمان انرژی و اگزرژی بیشترین مقدار خود

را دارد در m = 0.01 kg/s صورت می گیرد. همچنین با افزایش طول سلول فتوولتائیک-حرارتی راندمان انرژی کاهش ولی راندمان اگزرژی افزایش مییابد. که L = 2m به عنوان طول بهینه در نظر گرفته شد. مدل سازی برای گرمترین روز سال و ماه نشان داد توان تولیدی سلول فتوولتائیک-حرارتی با شدت تابش خورشیدی رابطه مستقیم دارد. و نزدیک ظهر توان تولیدی به ۱۸۰ وات می رسد. راندمان سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی را حدود ۳۵ لیک خورشیدی رابطه مستقیم دارد. و مورت انرژی و اگزرژی مورد بررسی قرار گرفت. راندمان انرژی را حدود ۳۵ لیک معرولتائیک-حرارتی با شدت تابش مدل می و ماه نشان داد توان تولیدی سلول فتوولتائیک-حرارتی با شدت تابش فتورشیدی رابطه مستقیم دارد. و نزدیک ظهر توان تولیدی به ۱۸۰ وات می رسد. راندمان سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی را به دو صورت انرژی و اگزرژی مورد بررسی قرار گرفت. راندمان انرژی را حدود ۳۵ لی ۲۰ درصد و راندمان انرژی را حدود ۱۱ ای ۱۲ درصد بدست آمد.

**واژههای کلیدی:** فتوولتائیک-حرارتی، موازنه انرژی،ضرایب انتقال حرارت ،راندمان انرژی و اگزرژی

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

۲- استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجهنصیر طوسی

۳- دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی نشان میدهد که سیستمهای فتوولتائیک توانایی تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته را با راندمانی در حدود ۵ الی ۲۰ درصد دارند یعنی پانل فتوولتائیک بخش کمی از تشعشع جذب شده را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند، مابقی آن به صورت حرارت تلف میشود. سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی این انرژی حرارتی را که باعث افزایش دمای پانل میشود و راندمان آن را کاهش میدهد احیا کرده و مورد استفاده قرار میدهند.

سیستم فتوولتائیک یک انتخاب مناسب برای کمک به کشورها به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای است. در سالهای اخیرنصب سیستمهای فتوولتائیک به طور متوسط در هر سال ۳۰٪ افزایش یافتهاست. دولتمردان ژاپنی انرژی خورشیدی را بخش مهمی ازترکیبات انرژی با هدف تولید ۱۰٪ الکتریسیته از سیستمهای فتوولتائیک در سال ۲۰۳۰ قرار دادند[1]. کرن و همکاران در سال ۱۹۷۸ اولین کسانی بودند که با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مفهوم اصلی سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی را که توسط دو سیال عامل آب و هوا عمل می کرد، ارائه نمودند. نتایج نشان داد که استفاده از سیال عامل آب باعث افزابش انتقال حرارت و در نتیجه افزایش راندمان حرارتی می شود. زیرا که خواص ترموفیزیکی آب از هوا بیشتر است ولی استفاده از هوا به دلیل هزینههای ساختاری کمتر رایج است[۲]. بازیلیان و همکاران در سال ۲۰۰۲ یک مدل عددی برای سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی در حالت جابجایی آزاد ارائه کردند. جابجایی آزاد هوای پشت پنلهای PV که برای خنککاری سیستم بکار می فت، برای گرمایش محل مورد استفاده در ساختمان قرار می گرفت. این مدل که توسط نرمافزار EES مدلسازی شد توانایی استفاده از شرایط آب و هوایی برای کارکرد سالانه سیستم بود[۳]. جوشی و همکاران در سال ۲۰۰۷، راندمان سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی را به دو صورت انرژی و اگزرژی مورد بررسی قرار دادند. آنان راندمان انرژی را حدود ۵۵ الی ۵۶ درصد و راندمان اگزرژی را حدود ۱۲ الی ۱۵ درصد بیان کردند[۴]. تئو و همکارانش در سال ۲۰۱۲ یک سیستم فتوولتائیک-حرارتی طراحی کردند و آن را مورد آزمایش قرار دادند برای خنک کردن فعال سلول های فتوولتائیک، یک آرایهی موازی از کانالها با منیفولد ورودی-خروجی جهت توزیع یکنواخت جریان هوا، طراحی و در پشت پنل PV وصل کردند. آزمایشات را با و بدون خنک کردن فعال انجام دادند. یک روند خطی بین دمای سلول و بازده به دست آمد بدون خنککردن فعال، دمای ماژول بالا بود C ۶۵° و سلول خورشیدی تنها میتوانست به بازده ۹٪ برسد اما زمانی که پنل فتوولتائیک در شرایط خنککردن فعال کار میکرد دما به صورت چشمگیری C  $^\circ$  ۶۵ کاهش پیدا کرد و بازده سلول خورشیدی به ۱۴٪ افزایش یافت. در این بررسی یک مدل شبیهسازی انتقال حرارت برای مقایسه با پروفایل دمای واقعی فتوولتائیک ایجاد شد که بین شبیهسازی و آزمایش توافق خوبی دیده شد[۵]. ری و همکاران در سال ۲۰۰۹ با استفاده از سلولهای فتوولتایئک-حرارتی به تأمین برق و نیاز آبگرم مصرفی یک مجموعه آموزشی با روش f چارت پرداختند. ذخیره انرژی را برای ماههای مختلف سال بدست آوردند[۶].

در این مقاله ابتدا با نوشتن معادلات موازنه انرژی و ضرایب انتقال حرارت،ضریب تلفات کلی سلول بدست میاید.سپس با وارد کردن پارامترهای طراحی برای سلولهای فتوولتایئک-حرارتی و مخزن دخیره حرارت به نرمافزار TRNSYS به شبیهسازی دینامیکی دمای سیال خروجی از سلول،دمای سلول،راندمان الکتریکی و حرارتی برای گرمترین ماه سال پرداخته و عوامل موثر بر کاهش یا افزایش راندمان انرژی و اگزرژی مورد بحث قرار گیرد.

# ۲- مشخصات سلول فتوولتائيک-حرارتي

طراحی سیستم انرژی خورشیدی در ارتباط با بدست آوردن کمینه هزینه انرژی است. بنابراین طراحی کلکتور با بازدهی بالاتر نسبت به فن آوری موجود در صورتی که هزینه به طور اساسی کاهش یابد مطلوب به نظر می سد. در هر صورت پیش بینی عملکرد سیستم خورشیدی ضروری بوده و هدف اصلی در این مقاله است. در این بخش یک سیستم فتوولتایی-حرارتی ساخت شرکت AnfaSolar شبیه سازی شده و نتایج حاصل از شبیه سازی جهت بدست آوردن دمای سیال خروجی در قالب نمودار بیان می شود. اجزای مختلف سیستم و کلیه ضرایب انتقال حرارت در مقطع عرضی ارائه شده در شکل (۱) نشان داده شده است. در این مدل سازی از یک پانل فتوولتایی نوع سیلیکونی پلی کریستالی که توان اسمی برابر با ۲۳۰ وات را داراست، استفاده شده است.



شكل (۱): اجزاء تشكيل دهنده سلول فتوولتائيك-حرارتي

پانلها بخشی از تشعشع رسیده را جذب می کنند که صرف تولید الکتریسیته و بالا رفتن دمای آنها میشود.تشعشع عبوری از پانلها توسط کلکتور حرارتی جذب می شود.عبور سیال از میان پانل فتوولتایی و کلکتور از بالا رفتن دمای پانلها جلوگیری کرده و باعث افزایش راندمان الکتریکی پانلها می شود.دمای هوای عبوری از کانالهای سیستم بر اثر جذب حرارت پانل فتوولتایی و کلکتور حرارتی،به واسطه انتقال حرارت جابجایی،افزایش می یابد. افزایش دمای سیال به افزایش راندمان حرارتی منجر می شود.پس با این نحوه طراحی می توان انرژی بر واحد سطح بیشتری به دست آورد.همانطور که در شکل (۱) مشاهده می شود یک سلول فتوولتائیک-حرارتی از چند لایه با روش تکنولوژی ساخت Thin Film تشکیل شده است که لایه اول مربوط به پوشش شیشهای، لایه ی دوم EVA<sup>1</sup> یک لایه پلاستیکی حاوی اتیلن وینیل استات است که سلول هتوولتائیک را در محفظه ای قرارمی دهد.

لایهی سوم شامل سلول سیلیکونی، لایهی چهارم باز فیلم نازکی از EVA ،است .لایهی پنجم به نام لایهی Tedlarیا ورق پشت فتوولتائیک که نقش محافظت ماژول PV از اشعه UV، رطوبت و خوردگی را دارست. همچنین به عنوان یک عایق الکتریکی محسوب میشود .لایههای بعدی شامل قاب آلومینومی و مجموعه کلکتورها است.

1-Ethylene Vinyl Acetate

### ۳- معادلات بقای انرژی

برای نوشتن معادلات بقای انرژی اجزای مختلف سیستم فتوولتائیک-حرارتی، المانی دیفرانسیلی به طول dx و به عرض b و به فاصله x از طول ورودی در نظر می گیریم. فرضیات مورد استفاده برای نوشتن معادلات انرژی عبارتست از: انتقال حرارت غیر دائم و یک بعدی، صرف نظر کردن از گرمای ویژه همه اجزا به جز سیال داخل کانالها، یکسان در نظر گرفتن ضریب انتقال حرارت جابجایی میان سیال داخل کانالها با پانل فتوولتایی،کلکتور حرارتی و جداره عایق و در نهایت تنوع درجه حرارت در طول ضخامت ناچیز گرفتهمی شود. با در نظر گرفتن فرضیات فوق اکنون به ارائه روابط بقای انرژی برای اجزای مختلف سیستم میپردازیم.همانطوری که در شکل (۱) مشاهده می شود سلول فتوولتائیک-حرارتی شامل لایههای مختلف ایزولاسیون برای جلوگیری از آسیب بخشهای مختلف تشکیل شده است.



تعادل انرژی برای سلول فتوولتائیک برای تک تک عناصر به شرح زیر است ضمن اینکه پارامترهای هر رابطه به تروی از چپ به راست توضیح داده می شود [Y]:  

$$\tau [a_c \beta_c I(t) + a_T (1 - \beta_c) I(t)] b dx = [U_t (T_c - T_a) + U_T (T_c - T_{bs})] b dx + \tau \eta_c I(t) \beta_c b dx \quad (1)$$

با استفاده از معادلهی (۱) دمای سلول بدست میآید :  

$$T_{c} = \frac{\tau \left[a_{c}\beta_{c} + a_{T}(1 - \beta_{c}) - a_{c}\eta\beta_{c}\right]I(t) + U_{t}T_{a} + U_{T}T_{bs}}{U_{t} + U_{T}}$$
(۲)

تعادل انرژی برای سطح پشت Tediar به شرح زیر است[۷]:  

$$U_T(T_c - T_{bs})bdx = h_T(T_{bs} - T_f)bdx$$
(۳)

$$T_{bs} = \frac{h_{p1}\tau[a_{c}\beta_{c} + a_{T}(1 - \beta_{c}) - a_{c}\eta\beta_{c}]I(t) + U_{tT}T_{a} + h_{T}T_{f}}{U_{tT} + h_{T}}$$
(f)

تعادل انرژی برای جریان سیال به شرح زیر است[۷]:

$$h_T (T_{bs} - Tf)bdx = m_f C_f (\frac{dT_f}{dx})dx + U_b (T_f - T_a)bdx$$
 (a)

با انتگرال گیری از معادله (۵) و با اعمال شرایط مرزی در  $T_f = T_{fi}$  در x = 0 میتوان دمای متوسط سیال را بدست آورد[۲]:

$$\overline{T}_{f} = \frac{1}{L} \int_{\circ}^{L} T_{f} dx = \left[ \frac{h_{p}h_{pr}(a\tau)_{eff} I(t)}{U_{L}} + T_{a} \right] \left[ 1 - \frac{m_{f} c_{f}}{\left(\frac{-bU_{L}L}{m_{f} c_{f}}\right)} \right] + T_{fi} \exp\left(\frac{-bU_{L}L}{m_{f} c_{f}}\right)$$
(2)

دمای خروجی سیال نیز با اعمال شرایط مرزی  $T_f = T_{f0}$  در  $\mathbf{x} = \mathbf{L}$  طبق رابطی زیر محاسبه می شود [۷]: (۷)

$$\begin{split} T_{fo} = & \left[ \frac{h_{p\uparrow} h_{p\intercal} (a\tau)_{eff} I(t)}{U_L} + T_a \right] \left[ 1 - \exp(\frac{-bU_L L}{m_f c_f}) \right] + T_{fi} \exp(\frac{-bU_L L}{m_f c_f}) \\ & : [\Upsilon] : [\Upsilon] : \\ & : [\Upsilon] : \\ \\ & : [\Psi] : \\ \\ & : [\Psi] : \\ \\ & : \\$$

$$\begin{split} U_t &= \left[ \begin{array}{c} \frac{L_g}{K_g} + \frac{1}{h_o} \end{array} \right]^{-1} \\ h_o &= \delta / \forall + \forall' / \lambda V, V = 1 (ms^{-1}) \\ U_{tT} &= \frac{U_t U_T}{U_t + U_T} \\ U_{tT} &= \frac{U_{tT} \cdot h_t}{U_{tT} + h_t} \\ U_L &= U_{tf} + U_b \\ h_{p1} &= \frac{U_T}{(U_t + U_T)} \\ h_{p\tau} &= \frac{h_T}{(U_t + U_T)} \\ (a\tau)_{ef} &= \tau \left[ a_c B_c + a\tau (1 - \beta_c) - \eta_c \beta_c \right] \end{split}$$

# ۴– تعادل انرژی

انرژی دریافتی مفید سلول فتوولتایئک-حرارتی با استفاده از معادلهی دافی بکمن بر حسب دمای ورودی به سلول و دمای محیط طبق رابطه زیر است[۷]:

$$\dot{Q}_{u} = A_{c} F_{R} \Big[ h_{p,h} h_{p,r} (a\tau)_{eff} I(t) - U_{L} (T_{fi} - T_{a}) \Big]$$
(9)

تعادل انرژی در اصل میگوید که دریافتی مفید در هر زمانی برابر اختلاف بین انرژی خورشیدی جذب شده و تلفات گرمایی از کلکتور مورد نظر است. تلفات به اختلاف دمای بین صفحه کلکتور و دمای محیط و یک ضریب اتلاف گرمایی وابسته است. با در نظر گرفتن یک ضریب، یک دمای کلکتور و یک دمای محیط (یعنی اتلاف گرمایی بر واحد سطح) یک مقدار تابش برخوردی برابر با تلفات وجود دارد. این مقدار تابش برخوردی تراز بحرانی تابش آن کلکتور تحت آن شرایط کاری است[ ۸]:

$$I(t) \ge \frac{U_L(T_{ff} - T_a)}{h_{p,h_{p,\tau}}(a\tau)_{eff}}$$

$$(1.)$$

# ۵- راندمان الکتریکی و حرارتی

راندمان الکتریکی مدول فتوولتائیک طبق رابطه (۵) تابعی از دمای آن است [۸]:  

$$\eta_{el} = \eta_{ref} \cdot \left[ 1 - \beta_{ref} (T_c - T_a) \right]$$
(۱۱)  
که درآن  $\eta_{ref}$  بازده ماژول در دمای مرجع ۲۰ درجه سلیسوس و برابر با ۱۳/۹٪ همچنین  $\beta_{ref}$  ضریب دمای بازده ماژول که با توجه به انتخاب پنل های شرکت AnfaSolar در حدود ۲/۵٪ است.  $T_c$  دمای سلول و  $T_a$  دمای محیط است.

یک معیار ارزیابی عملکرد کلکتور،بازدهی کلکتور میباشدکه به صورت نسبت دریافت مفید در طول یک مدت زمان مشخص به انرژی خورشیدی برخوردی در مدت زمان مشابه است [۸]:

$$\eta_{th} = \frac{\int Q_u dt}{A_c \int G_T dt} \tag{11}$$

# ۶- راندمان انرژی و اگزرژی

راندمان اگزرژی طبق قانون دوم ترمودینامیکی شامل اگزرژی وروی سیال، اگزرژی خروجی سیال و اگزرژی تلفات در سیستم است. برای انجام آنالیز اگزرژی بر روی سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی،راندمانهای الکتریکی ،حرارتی و مجموع مورد استفاده قرار میگیرند که برای سیستم مورد بررسی با استفاده از روابط زیر محاسبه میشوند:

$$\sum E x_{in} - \sum E x_{out} = \sum E x_{dest}$$
(17)

$$\sum E x_{in} - (E x_{in} - E x_{work}) = E x_{dest}$$

که برای اگزرژی ورودی با توجه به شدت تایش خورشید داریم:

$$E x_{in} = E x_{sun} = A_s \times I(t)_s \times \left[ 1 - \frac{4}{3} \times (\frac{T_a}{T_s}) + \frac{1}{3} \times (\frac{T_a}{T_s})^4 \right]$$
(14)

که در آن 
$$I(t)$$
 شدت تابش برخوردی،  $A_s$  مساحت کلکتـور،  $T_a$  دمـای محـیط و  $T_s$  دمـای خورشـید کـه برابـر 5777 $K$  است.  
همچنین اگزرژی سیال آب گرم داخل سیستم طبق رابط زیر محاسبه میشود[۹]:

$$\dot{E} x_{th} = \sum \left(1 - \frac{T_a + \tau \gamma \tau}{T_w + \tau \gamma \tau}\right) \times \dot{Q}_u \tag{10}$$

$$\dot{Q}_u = \dot{M}_w C_w (T_w - T_a).$$

$$E x_{work} = W = \eta \times I(t) \times A_s \tag{19}$$

 $T_a$  که برای این روابط  $\eta$  راندمان الکتریکی سلول ،  $M_w$  وزن مخزن،  $C_w$  ظرفیت سیال مخزن،  $T_w$  دمای مخزن، دمای مخزن، دمای محزن، دمای محزن،  $r_a$ 

$$\eta_{ex} = 1 - \frac{Ex_{dest}}{Ex_{in}}$$
(1Y)

در این تحقیق جهت بدست آوردن راندمان انرژی یا همان راندمان کلی حرارتی وراندمان اگزرژی از دو رابطه زیر استفاده شده است[۹]:

$$\eta_{oth} = \frac{\eta}{\cdot r\lambda} + \eta_{th} \tag{1}$$

$$\eta_{oex} = \eta + \eta_{th} \left[ 1 - \frac{T_a + \tau \tau \nu}{T_w + \tau \tau \nu} \right]$$
(19)

# ۶-مدلسازی سلول فتوولتائیک-حرارتی با استفاده از نرمافزار TRNSYS

در این بخش سیکل کاری سیستم فتوولتائیک-حرارتی، با استفاده از نرمافزار Trnsy مدل خوهد شد. مراحل انجام مدلسازی شامل وارد کردن اطلاعات آب و هوایی منطقه نمونه شهر تبریز، (باید توجه داشت که چون کلیه اطلاعات این نرمافزار اعم از دما و یا تابش به صورت ساعتی است لذا با انتگراسیون میتوان اطلاعات روزانه و یا سالانه را بدستآورد) وارد کردن اطلاعات مربوط به سیستم فتوولتائیک-حرارتی، مخزن، پمپ و سیستم کنترل است. همچنین اطلاعات ورودی بار مصرفی بایستی با تعریف یک پروفایل مصرف به صورت ساعتی وارد نرمافزار شود.که در صورت نیاز به بررسی وارد نرمافزار می شوند.

با توجه به مشخصات الکتریکی و حرارتی سلول فتوولتائیک-حرارتی کلیه اطلاعات مربوط به ساختار پنلهای پلی کریستالی ۲۳۰ واتی ساخت شرکت Anafsolar طبق جدول (۱) وارد نرمافزار می شوند. هدف از این بخش تحلیل دمای سیال خروجی از سلول فتوولتائیک-حرارتی،دمای سلول،راندمان الکتریکی و حرارتی،همچنین تحلیل اگزرژی سیستم با توجه به شرایط آب و هوایی اقیلم سردسیر تبریز است در سیستم کنترلر به دو سنسور دما نیاز ناست که یک سنسور در پایین واحد ذخیره و یکی در محل خروجی سیال ازکلکتور نصب شود. زمانیکه دمای خروجی سیال از سلول فتوولتائیک-حرارتی از دمای متوسط مخزن بیشتر باشد پمپ روشن است در غیر این صورت خلموش است.خاموش و روشن شدن پیوسته پمپ هنگام صبح ممکن است به وقوع بپیوندد. زیرا سیال درون پمپ یا کانال های بین واحد ذخیره و کلکتور از دمای پایین مخزن خنکتر خواهد بود در نتیجه زمانیکه پمپ روشن می شود مایع سرد وارد سلول فتوولتائیک-حرارتی شده که کنترل کننده پمپ را خاموش می کند تا وقتی که مایع درون می سرد وارد سلول فتوولتائیک-حرارتی شده که کنترل کننده پمپ را خاموش می کند تا وقتی که مایع درون پمپ سرد وارد سلول فتوولتائیک-حرارتی شده که کنترل کنده پمپ را خاموش می کند تا وقتی که مایع درون پمپ سرد وارد سلول فتوولتائیک-حرارتی شده که کنترل کنده پمپ را خاموش می کند تا وقتی که مایع درون می کند.شکل (۳) مدل طراحی سیکل را نمایان می کند.که شامل یک عدد سلولهای فتولتائیک-حرارتی،۲ عدد پمپ سیرکلاسیون،یک عدد کنترل دما و یک مخزن ذخیره حرارت است. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، رفتار دینامیکی سیستم برای هر ساعت از سال قابل محاسبه است. ولی در این نحقیق رفتار دینامیکی سیستم، برای

علايم	مقدار	واحد	پارامترهای طراحی برای سلول فتوولتائیک-حرارتی و مخزن
$\alpha_{c}$	•/٩		ضريب جذب سلول فتوولتائيك
$\alpha_{T}$	•/۵		ضریب جذب لایهی تدلار
τ	۰/۹۵		ضريب عبور
β	•/••۴۵		ضريب دمايى سلول فتوولتائيك
$\beta_c$	•/٩		فاكتور بستهبندى سلول فتوولتائيك
$h_{p1}$	• /AY		فاکتور پنالتی مربوط به پوشش شیشهای ماژول
$h_{p2}$	٠/٩٨		فاکتور پنالتی مربوط به لایهی تدلار ماژول
$\eta_{\scriptscriptstyle ref}$	٪ ۱۳/۹		راندمان الکتریکی پانل فتوولتائیک در دمای مرجع
L	۱/۶	т	طول سیستم
b	١	т	عرض سيستم
D	۰/۰۵	т	قطر کانال سیال
n	١٩		تعداد کانالها
A <sub>c</sub>	1/48	$m^2$	مساحت كلكتور
´ m	• / • ۲	kg / s	دبی جرمی سیال
P <sub>max</sub>	۲۳۰	W	ماکریمم توان خروجی
$\mathcal{C}_{f}$	۴/۱۹	KJ / Kg.K	ظرفیت گرمای ویژه سیال
$C_w$	4/19	KJ / Kg.K	ظرفیت گرمای ویژه مخزن
$(UA)_s$	11/1	W / K	حاصلضرب سطح در ضریب اتلاف مخزن
$h_0$	١٠	$W/m^2K$	ضريب انتقال حرارت باد
$h_{f}$	۵۰۰	$W/m^2K$	ضريب انتقال حرارت داخلى لوله
$l_G$	•/••٣	т	ضخامت پوشش شیشهای
$l_c$	•/•••٣	т	ضخامت سلول فتوولتائيك
$l_T$	•/••۵	т	ضخامت لایهی تدلار
K <sub>G</sub>	١	W / mK	ضریب هدایت حرارتی پوشش شیشهای
K <sub>c</sub>	•/•٣٩	W / mK	ضريب هدايت حرارتى سلول فتوولتائيك
$K_T$	•.• ٣٣	W / mK	ضریب هدایت حرارتی لایهی تدلار
$U_b$	•/87	$W/m^2K$	ضریب تلفات از عایق به محیط اطراف
$U_t$	٩/٢۴	$W/m^2K$	ضریب تلفات از سلول فتوولتائیک به محیط از طریق شیشه
$U_{tT}$	٨/ ١	$W/m^2K$	ضریب انتقال حرارت کلی از پوشش شیشهای تا تدلار توسط سلول فتوولتائیک
$U_T$	۶۵	$W/m^2K$	ضريب انتقال حرارت سلول فتوولتائيك به سيال توسط لايهى تدلار
$h_T$	<i><b>۶</b>۶</i>	$W/m^2K$	ضریب انتقال حرارت از صفحهی پشت تا سیال توسط لایهی تدلار
I(t)	متغيير	$W/m^2$	شدت تابش ورودی
$T_a$	متغيير	°c	دمای محیط
$T_c$	متغيير	°c	دمای سلول
T <sub>fo</sub>	متغيير	°c	دمای سیال خروجی
$T_{fi}$	متغيير	°C	دمای سیال ورودی

جدول (۱): مشخصات سلول فتوولتائیک-حرارتی و مخزن



شکل (۳): طراحی سیکل توسط نرم افزار Trnsys

#### ۹-۱-۹ محاسبه میزان تشعشع خورشید

با استفاده از مدل پخش همسانگرد کل شار تشعشعی که به یک سطح شیبدار برای یک ساعت میرسد شامل سـه بخش تابش مستقیم، تابش پخشی و تابش بازتابی است [۸]:

$$I_T = I_b R_b + I_d \left(\frac{1 + \cos\beta}{2}\right) + I \rho_g \left(\frac{1 - \cos\beta}{2}\right) \tag{(Y \cdot)}$$

مجموعه تابش پخشی از آسمان و تابش بازتابی زمین روی سطح شیبدار، بدون توجه به جهت ،یکسان میباشند سهم تابش مستقیم به عنوان  $I_b R_b$ است. در واقع یک سطح با شیب  $\beta$  نسبت به افـق دارای فـاکتور دیـدی به آسمان به صورت  $\left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right)$  است، که اگر تابش پخشی همسانگرد باشد عبارت  $\left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right)_b I$  سهم تـابش آسمان به صورت  $\left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right)$  است، که اگر تابش پخشی همسانگرد باشد عبارت  $\left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right)_b I$  سهم تـابش پخشی خواهد بود. سطح شیبدار دارای دیدی به زمین  $\left(\frac{1-\cos\beta}{2}\right)$  بوده و اگر محیط اطـراف دارای یـک ضـریب بازتابش  $p_g$  برای تابش کل خورشیدی باشد تابش بازتابی از محیط اطراف به روی سطح براب  $\left(\frac{1-\cos\beta}{2}\right)_c$  واهد بود. ضریب انعکاس زمین اطراف است که صفحه گیرنده آن را می بیند.معمولاً محمدار کوچک است، برای روزهای معمولی ۲/۰ =  $p_g$  و برای حالتی که مقابل صفحه گیرنده آن را می بیند.معمولاً محمدار کوچک است، برای روزهای معمولی ۲/۰ =  $p_g$  و برای حالتی که مقابل صفحه گیرنده آن را می بیند.معمولاً محمدار کوچک است. برای روزهای معمولی ۲/۰ =  $p_g$  و برای حالتی که مقابل صفحه گیرنده آن را می بیند.معمولاً محمدار کوچک است. برای روزهای معمولی ۲/۰ =  $p_g$  و برای حالتی که مقابل صفحه گیرنده آن را می بیند.معمولاً محمدار کوچک است. برای روزهای معمولی ۲/۰ =  $p_g$  و برای حالتی که مقابل صفحه گیرنده آن را می بیند.معمولاً محمدار کوچک است. برای روزهای معمولی ۲/۰ =  $p_g$  و برای حالتی که مقابل صفحه گیرنده آن را می بیند.معمولاً را از آلمان می گردد.که در این مقاله ۵/۰ در نظر گرفته شده است. همجنین  $R_b$  نسبت تابش مستقیم روی سطح شیبدار به تـابش مستقیم روی سطح شیبدار به تـابش مستقیم روی سطح شیبدار به تـابش مستقیم روی سطح فیرابر با [۸]:

$$R_{b} = \frac{\cos(\phi - \beta)\cos\delta\cos\omega + \sin(\phi - \beta)\sin\delta}{\cos\phi\cos\delta\cos\omega + \sin\phi\sin\delta}$$
(71)

که در رابطهی مزبور،  $\phi$ عرض جغرافیایی بوده و برابر با ۳۸ درجه،  $\delta$ زاویه میل و eta زاویهی شیب پنلها نسبت به سطح افق است .با توجه به روابط اشاره شده میزان تشعشع خورشیدی عمود تابیده شده بر سطوح پنلها با زاویهی

نصب فصلی برای ۸۷۶۰ ساعت از سال توسط نرمافزار Trnsys محاسبه شدهاست.به عنوان مثال در شکلهای (۴) و(۵) میزان تابش مستقیم و تابش پخشی و دمای محیط برای یک روز در زمستان و تابستان رسم شدهاست.



#### ۲-۶-بررسی رفتار دینامیکی سیستم

برای ارزیابی عملکرد سلول فتوولتائیک-حرارتی، دانستن ضریب تلفات کلی و ضریب داخلی انتقال حرارت سیال ضروری است. با در نظر گرفتن پارامترهای طراحی برای سلول فتوولتائیک-حرارتی و مخزن ذخیره حرارت طبق جدول (۱)، ضریب اتلاف حرارت پانل فتوولتائیک به محیط اطراف  $(^{-1}K^{-1})$  بدست میآید . طبق معادله(۱۱)، از جمله مشخصاتی که بر بازدهی پنلها تاثیر مستقیمی میگذارد دمای سطح ماژول است. شکل (۹) مربوط به سیستم فتوولتائیک-حرارتی است که گویای این مطلب است که با افزایش دمای محیط و دمای سلول فتوولتائیک- حرارت و مخزن ذخیره حرارت علی . (۱)، ضریب اتلاف حرارت پانل فتوولتائیک به محیط اطراف (۱)، ضریب اتلاف حرارت پانل فتوولتائیک به محیط اطراف (۱)، ضریب الاف حرارت پانل فتوولتائیک به محیط اطراف (۱)، ضریب اندان به مشخصاتی که بر بازدهی پنلها تاثیر مستقیمی میگذارد دمای سطح ماژول است. شکل (۹) مربوط به سیستم فتوولتائیک-حرارتی است که گویای این مطلب است که با افزایش دمای محیط و دمای سلول فتوولتائیک، برای هفته اول ماه گرم سال (ژولای) راندمان الکتریکی کاهش مییابد. ولی برای این سلول فتوولتائیک به حرارتی به علت خنککاری توسط سیال عامل آب،کاهش راندمان به نسبت خیلی کمتر از سلول فتوولتائیک به حرارتی است.



شکل (۶): افزایش دمای سلول فتوولتایئک -حرارتی با افزایش دمای محیط و کاهش راندمان الکتریکی

#### ۶–۳–بررسی توان تولیدی سلول فتوولتائیک-حرارتی

با توجه به شکل (۷) توان ساعتی تولیدی سلول فتوولتائیک-حرارتی(POWer) و توان مصرفی پمپ سیرکلاسیون بین سلول فتوولتائیک-حرارتی و مخزن (Pomp Power)،همچنین توان خالص تولیدی – Net) (saving) برای روز اول ژولای قابل مشاهده است.با توجه به کارکرد پمپ از ساعت ۸ الی ۱۸ ،نتایج حاکی از آن است که توان تولیدی سلول با افزایش شدت تابش برخوردی بین ساعات ۱ الی ۲ ظهر افزایش قابل چشمگیری دارد.هر چند راندمان الکتریکی با توجه به افزایش دما،کاهش می ابد ولی توان تولیدی همچنان در حالت ماکزیمم خود قرار دارد.همچنین نتایج مربوط به توان خالص تولیدی برای ماه ژولای در شکل (۸) قابل مشاهده است



شکل (۷): توان تولیدی سلول،توان مصرفی پمپ و توان خالص تولیدی برای روز اول ژولای



شکل (۸) : توان تولیدی سلول،توان مصرفی پمپ و توان خالص تولیدی برای برای ماه ژولای

# ۶-۴-بررسی طول سلول فتوولتائیک-حرارتی در راندمان کلی انرژی و اگزرژی

همانطور که در شکل های (۹) و (۱۰) مشاهده می شود با افزایش طول سلول فتوولتائیک-حرارتی،رانـدمان حرارتـی کاهش اما راندمان اگزرژی با توجه به رابطه (۱۹) افزایش می یابد.نقطه بهینه در L=2 متر برای سلول فتوولتائیـک-حارت همانطوری که در شکلی (۱۱) قابل مشاهده است،بدست آمد.



شکل (۹): راندمان کلی انرژی واکزرژی برای سلول فتوولتائیک-حرارتی با طول ۱.۶ متر



شکل (۱۰):راندمان کلی انرژی واکزرژی برای سلول فتوولتائیک-حرارتی با طول ۶ متر



شکل (۱۱): اثر طول سلول فتوولتائیک-حرارتی بر راندمان کلی انرژی و اگزرژی

۶-۵-بررسی دبی سیال در راندمان کلی انرژی و اگزرژی در این قسمت اثرات افزایش دبی سیال بر راندمان کلی انرژی و اگزرژی بررسی میشود. همانطوری که در شکل (۱۲) مشاهده میکنیم با افزایش دبی سیال راندمان اگزرژی افزایش ولی راندمان کلی انرژی برعکس آن کاهش مییابد، راندمان کلی انرژی در ماکزیمم مقدار خود m = 0.01kg/sرا دارد. لذا حالت بهینه را در m = 0.01kg/s/s/s/s



# ۶-۶-محاسبه راندمان انرژی و اگزرژی برای سیستم مورد نظر

راندمان سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی را به دو صورت انرژی و اگزرژی مورد بررسی قرار گرفت. برای ۶ ماهه اول ،راندمان انرژی حدود ۳۵ الی ۷۰ درصد و راندمان اگزرژی را حدود ۱۱ الی ۱۳ درصد بدست آمد.



شکل (۱۲): راندمان کلی انرژی و اگزرژی برای ۶ ماه اول بهار و تابستان

#### ۷- نتیجهگیری

در این تحقیق با مدلسازی یک سیستم فتوولتائیک-حرارتی با استفاده از نرم افزار TRANSYS رفتار دینامیکی دمای سیال خروجی از سلول فتوولتائیک-حرارتی، دمای سلول، بازده الکتریکی،بازده حرارتی تحلیل شده و عوامل موثر بر افزایش راندمان انرژی و اگزرژی بررسی شد.نتایج حاصل از تغییرات دبی سیال نشان داد که حالت بهینه دبی

مراجع:

- [1]- New Energy and Industrial Technology Development Organiza, on (NEDO)., 2004, Overview of "PV Roadmap Toward 2030". Japan, Tokyo.
- [2]- Kern. C., Russell. M.C., 1978. "Combined Photovoltaic and Thermal Hybrid Collector Systems." In Proceedings of the 13th IEEE PV Specialist Conference, Washington, DC. 5–8. p. 1153–7.
- [3]- Bazilian. M, Prasad, D., 2002. "Modelling of a Photovoltaic Heat Recovery System and its Role in a Design Decision Support Tool for Building Professionals." Renewable Energy 27, 57-68.
- [4]- Joshi .A, Tiwari. A., 2007. "Energy and Exergy Efficiencies of a Hybrid Photovoltaic- Thermal Air Collectors." Renewable Energy 32, 2223–2241.
- [5]- Teo .H.G., Lee . P.S., M.N.A. Hawlader, 2012, "An active cooling system for photovoltaic modules", Applied Energy 90 .309–315.
- [6]- Rey.D., Manuel.B, Francisco.C, Fernandez.A,2009. "Solar mixed thermal and photovoltaic installation for an infantile educational-sanitary lodging in Senkata-El Alto (BOLIVIA)." International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'09)
- [7]- S., Agraval, G., Tiwari ,2011, "Performance evaluation of hybrid modified micro-channel solar cellthermal tile", Vol. 3, No. 1, 2011, pp. 244-254.
- [8]- Duffie. J. A, Beckman. W. A, Solar Engineering of Thermal Processes Wiley, Interscience, University of Wisconsin-Madison, 1980.
- [9]- Hepbasli A. Exergetic modelling and assessment of solar assisted domestic hot water tank integrated groundsource heat pump systems for residences. Energy Build 2007;39:1211–7.

# Energy and exergy analysis of Thermalphotovoltaic cells with TRANSYS modeling and factors of affecting their

Elgar athari<sup>1</sup>, Farshad Torabi<sup>2</sup>, Ahmad Tavasoli

1-elgar.athari@gmail.com 2-ftorabi@kntu.ac.ir

#### Abstract

Performance of Thermal-photovoltaic cells affected by various parameters such as temperature. Also evaluate the performance of Thermalphotovoltaic cells, it's essential to know the overall losses rate that is dependent on weather conditions. In this study with modeling of the Thermal- photovoltaic system with TRANSYS Software, theDynamic outlet fluid temperature of Thermal-photovoltaic cells, cell temperature, electrical efficiency, thermal efficiency and exergy analysis and factors influencing energy efficiency will be investigated.

Results showed that the optimal flow rate m = 0.01 kg/s occurs when the energy and exergy efficiency has its maximumvalue. Also with increasing the length's of Thermal-photovoltaic cell, energy efficiency reduces while the thermal exergy efficiency increases. So considered L = 2m as the optimal length. Modeling the warmest day, showed the generated power of photovoltaic cells has a direct relationship with Thermal solar radiation intensity, And 180 watts can be produced at noon. The efficiency of thermal photovoltaic systems are investigated in two ways, energy and exergy. Approximately reach %35 to %70 energy efficiency and exergy efficiency of about %11 to %13 respectively.

**Keywords:** Thermal-Photovoltaic cell , energy balance, heat transfer coefficients, energy and exergy efficiency